

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 4 月 2 1 日
Date of Application:

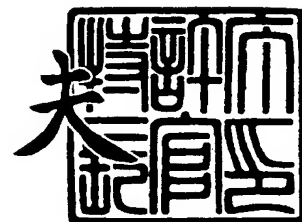
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 1 6 3 9 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 1 1 6 3 9 2]

出 願 人 株式会社半導体エネルギー研究所
Applicant(s):

2 0 0 4 年 2 月 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 0 6 1 2 4

【書類名】 特許願

【整理番号】 P007098

【提出日】 平成15年 4月21日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 田中 幸一郎

【特許出願人】

 【識別番号】 000153878

 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

 【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 002543

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ビーム照射装置、ビーム照射方法、及び薄膜トランジスタの作製方法

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、

前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、

を有することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 2】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、

前記走査する手段と同期して、前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、

を有することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 3】

連続的に出力される複数のエネルギービームを被照射物上において、それぞれ一端から他端へ走査する複数の手段と、

前記一端及び前記他端において前記ビームをそれぞれ遮光する複数の手段と、

を有することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 4】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、

前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、

を有するビーム照射装置であって、

前記走査する手段は、平面又は曲面を有する鏡面体を有し、前記鏡面体は前記ビームの光軸上に配置されるよう軸に固定され、前記軸を中心として前記鏡面体は振動することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 5】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において走査する手段と、
前記ビームの走査開始位置と走査終了位置において前記ビームを遮光する手段と

、
を有するビーム照射装置であって、

前記走査する手段は、平面又は曲面を有する鏡面体を有し、前記鏡面体は前記ビームの光軸上に配置されるよう軸に固定され、前記軸を中心として前記鏡面体は回転することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 6】

請求項 4 又は 5 において、前記軸は、一端部、又は両端部に支持棒が設けられることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 7】

請求項 4 乃至 6 のいずれか一において、前記鏡面体は 1 つ設けられることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 7 のいずれか一において、
前記被照射物と、前記ビームを相対的に移動させる手段を有することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 9】

請求項 8 において、前記移動させる手段は、前記走査する手段の走査と同期して移動するように制御する制御装置を有することを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 10】

請求項 1 乃至 9 のいずれか一において、前記連続的に出力されるエネルギービームは、YVO₄レーザ、YAGレーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、及びArレーザのいずれかであることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 11】

請求項 1 乃至 10 のいずれか一において、前記連続的に出力されるエネルギービームを線状に加工する光学系を有し、前記光学系は前記ビームの発振器と、前記走査する手段との間に配置されることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 12】

請求項 1 乃至 1 1 のいずれか一において、前記遮光する手段は前記走査する手段の付近に配置されることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 3】

請求項 1 乃至 1 1 のいずれか一において、前記遮光する手段は前記被照射物の付近に配置されることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 4】

請求項 1 乃至 1 3 のいずれか一において、前記遮光する手段は、前記ビームを反射する反射体、又は前記ビームを吸収する吸収体を有する遮光板であることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 5】

請求項 1 4 において、前記遮光板には矩形の開口部が設けられることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 6】

請求項 1 5 において、前記開口部の長軸方向の長さは 3 ～ 3 0 c m であることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 7】

請求項 1 乃至 1 6 のいずれか一において、前記走査する手段と、前記被照射物と、の間には $f \theta$ レンズが配置されることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 8】

請求項 1 乃至 1 6 のいずれか一において、前記走査する手段と、前記被照射物と、の間にはテレセントリック $f \theta$ レンズが配置されることを特徴とするビーム照射装置。

【請求項 1 9】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物に走査しながら照射するビーム照射方法において、
前記被照射物上において、前記ビームの走査方向が変わる位置を遮光することを特徴とするビーム照射方法。

【請求項 2 0】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物に走査しながら照射するビーム

照射方法において、

前記被照射物上において、前記ビームの走査開始位置と走査終了位置とを遮光することを特徴とするビーム照射方法。

【請求項 2 1】

連続的に出力されるエネルギービームと、被照射物とを相対的に走査しながら照射するビーム照射方法において、

複数の鏡面体により前記ビームが順に反射することにより、前記被照射物进行处理し、

前記ビームを反射する鏡面体が変わる毎に、前記ビームと、前記被照射物との相対的な位置を設定し、

前記被照射物上において、前記ビームの走査開始位置と走査終了位置とを遮光することを特徴とするビーム照射方法。

【請求項 2 2】

請求項 1 9 乃至 2 1 のいずれかにおいて、前記連続的に出力されるエネルギービームを走査する手段はガルバノミラー又はポリゴンミラーを有することを特徴とするビーム照射方法。

【請求項 2 3】

請求項 1 9 乃至 2 2 のいずれかにおいて、前記連続的に出力されるエネルギービームは、YVO₄レーザ、YAGレーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、及びArレーザのいずれかであることを特徴とするビーム照射方法。

【請求項 2 4】

連続的に出力されるエネルギービームを半導体膜に走査しながら照射して結晶性半導体膜を形成し、

前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、

前記ゲート電極をマスクとして前記結晶性半導体膜に不純物領域を形成する薄膜トランジスタの作製方法において、

前記半導体膜上において、前記ビームの走査方向が変わる位置を遮光することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 2 5】

連続的に出力されるエネルギービームを半導体膜に走査しながら照射して結晶性半導体膜を形成し、

前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、

前記ゲート電極をマスクとして前記結晶性半導体膜に不純物領域を形成する薄膜トランジスタの作製方法において、

前記半導体膜上において、前記ビームの走査開始位置と走査終了位置とを遮光することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 2 6】

請求項 2 4 又は 2 5 において、前記走査する手段はガルバノミラー又はポリゴンミラーを有することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 2 7】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、を有するビーム照射装置を用いて結晶性半導体膜を形成し、

前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、

前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に不純物領域を形成することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 2 8】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、前記走査する手段と同期して、前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、を有するビーム照射装置を用いて結晶性半導体膜を形成し、

前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、

前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に不純物領域を形成することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 2 9】

連続的に出力される複数のエネルギービームを被照射物上において、それぞれ一端から他端へ走査する複数の手段と、

前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する複数の手段と、を有するビ

ーム照射装置を用いて結晶性半導体膜を形成し、
前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、
前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に不純物領域を形成することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 3 0】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、を有し、前記走査する手段は、平面又は曲面を有する鏡面体を有し、前記鏡面体は前記ビームの光軸上に配置されるよう軸に固定され、前記軸を中心として前記鏡面体は振動するビーム照射装置を用いて結晶性半導体膜を形成し、
前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、
前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に不純物領域を形成することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 3 1】

連続的に出力されるエネルギービームを被照射物上において一端から他端へ走査する手段と、前記一端及び前記他端において前記ビームを遮光する手段と、を有し、前記走査する手段は、平面又は曲面を有する鏡面体を有し、前記鏡面体は前記ビームの光軸上に配置されるよう軸に固定され、前記軸を中心として前記鏡面体は回転するビーム照射装置を用いて結晶性半導体膜を形成し、
前記結晶性半導体膜上にゲート電極を形成し、
前記ゲート電極をマスクとして前記半導体膜に不純物領域を形成することを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【請求項 3 2】

請求項 2 7 乃至 3 1 のいずれか一において、前記連続的に出力されるエネルギービームは、YVO₄レーザ、YAGレーザ、YLFレーザ、Y A l O₃レーザ、及びA r レーザのいずれかであることを特徴とする薄膜トランジスタの作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ビーム照射装置、ビーム照射方法に関する。さらに本発明は、当該装置及び方法を用いた薄膜トランジスタの作製方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

表示装置や集積回路等が有する半導体素子として、チャネル形成領域に多結晶半導体膜を有する薄膜トランジスタ（以下、多結晶 T F T と表記する）の研究が行われている。表示装置や集積回路の発達に伴い、多結晶 T F T のさらなる特性向上が求められている。

【 0 0 0 3 】

そこで多結晶 T F T の特性向上のため、連続発振型レーザによる半導体膜の結晶化が行われている。例えば、ガラス基板上に a - S i 膜を線状又は島状にパターンニングし、C W レーザから時間に対して連続的に出力するエネルギービームを照射走査して a - S i 膜を結晶化する。また半導体薄膜を予め線状又は島状にパターンニングしておくことにより、ガラス基板の温度は上がらず、クラックの発生等を防止している（特許文献 1 参照）。

【 0 0 0 4 】

またレーザ光を走査（偏向ともいう）させる手段としてガルバノミラー（特許文献 2 参照）やポリゴンミラー（特許文献 3 参照がよく用いられ、これは走査速度を高速化することが容易なためである。これにより、装置の負担を低減させることができる。

【 0 0 0 5 】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 3 - 8 6 5 0 5 号公報

【特許文献 2】

特開 2 0 0 3 - 8 6 5 0 7 号公報

【特許文献 3】

特開 2 0 0 3 - 4 5 8 9 0 号公報

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上述のようなCWレーザをガルバノミラーやポリゴンミラーを使って大型基板に照射する場合、走査幅に限度があった。そのため、複数回レーザ光の走査を繰り返す必要があり、レーザ光の走査が停止する領域での均一なレーザ処理は難しかった。

【0007】

更にガルバノミラーやポリゴンミラー等の走査手段により走査されるレーザの速度は、走査幅の中心部と端部とで速度が一樣とならなかった。すなわち例えば、ガルバノミラーにより第一の方向に往復運動させられたCWレーザは、往復運動の速度の向きが変わる領域（ガルバノミラーの止まり際）に向かって減速し、ついには速度がゼロとなり、その後は加速する。このような速度が減速、加速し、さらにゼロになる領域では照射時間が長くなり、被照射物に必要以上のエネルギーが照射され、非晶質半導体膜に膜剥がれ等が生じる恐れがあった。

【0008】

一方ポリゴンミラーでは、速度はゼロとならないものの、やはり、走査幅の中心部と端部とでは速度が一樣とならなかった。

【0009】

以上のように、均一なCWレーザの照射を行うには改良の余地があった。特に大型基板や量産を考えると、改良すべき点は多かった。

【0010】

そこで本発明は大型基板や量産を考え、被照射物に均一なレーザを照射するレーザ装置、及びレーザ照射方法を提供することを課題とする。またさらに、上記のようなレーザ照射装置、及びレーザ照射方法を用いて薄膜トランジスタ（以下、TFTと表記する）に対する均一なレーザアニール（結晶化や活性化を含む）を提供することを課題とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記課題を鑑み本発明は、連続的に出力されるエネルギービーム（CWビーム。特に、光源にレーザを使用する場合CWレーザと表記する。）の被照射物上でのスポット（照射領域）を、走査手段（偏向手段）等により往復運動させて走査

する場合、スポットの走査速度（移動速度）が所定値以外、例えば速度が一定でなく、増加、減少及びゼロの領域、つまり走査開始位置（一端）及び走査終了位置（他端）となるとき、被照射物に照射されるCWビームを遮断（遮光）する。すなわち本発明は、走査手段と同期させて、ビームの走査速度が一定とならない所定の位置と遮光手段を配置させることを特徴とする。

【0 0 1 2】

遮光手段は、遮光板を用いればよく、ビームを反射する反射体又はビームを吸収する吸収体を有する構成とすればよい。また遮光板の形状は適宜設定すればよく、ビームの走査速度が一定とならない範囲が被照射物に当たらなければよい。また走査手段と同期させて遮光することができればよく、チョッパーのような遮光手段を用いてもよい。

【0 0 1 3】

走査手段は、被照射物に対するレーザビームの入射角を連続的又は矩形的に変化させる鏡面体（ミラーともいう）、例えば、単数又は複数の鏡面体を有する手段、複数の連続して配置された鏡面体を有する手段、又はその他のミラーを有する手段を用いることができる。具体的には、ガルバノミラーやポリゴンミラーが挙げられる。その他としては、軸上に平面又は曲面を有する鏡面体を固定し、前記軸を中心として回動（回転や振動を含む）し、鏡面体がビームの光軸上に配置されるミラーを用いることができる。軸の一端部又は両端部に支持棒が設けられ、軸、すなわち鏡面体の回動（回転速度、振動幅）を制御する手段が設置されている。また鏡面体は単数であると好ましい。

【0 0 1 4】

なおガルバノミラーやポリゴンミラーを用いると、走査速度が10～数1000mm/sとかなりの高速にもかかわらず、加減速に要する時間が短いため、処理時間を短縮することができる。これはガルバノミラーやポリゴンミラーが軽量であるため、加減速が高速で行えるためである。

【0 0 1 5】

連続的に出力されるエネルギービームとしては、固体レーザを用いればよく、例えばYVO₄レーザや、YAGレーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、Arレーザ等

が当てはまる。またその他のレーザの高調波でも使用できる。

【0016】

なおビームは、任意の形状で構わず、好ましくは光学系を通過することにより線状となるように加工する。なおここでいう「線状」は、厳密な意味で「線」を意味しているのではなく、アスペクト比の大きい長方形（または長楕円形）を意味する。例えば、アスペクト比が10以上（好ましくは100～10000）のもの指す。例えば、線状のビームのスポット径は、長軸150～1000 μ m、短軸5～20 μ mとする。線状に加工されたビームを用いると、スループットの高い処理を行うことができる。

【0017】

なお被照射物とビームとが相対的に移動して一列を処理し、その後、次列を処理できるように被照射物とビームとが移動して処理を開始する。このような相対的な移動を繰り返して大型面積の処理が行われる。そのため、ビームの走査速度や被照射物の走査速度は、互いに同期させるように設定する。すなわち、ビームの進行方向（走査方向）を変化させる第一の走査手段と、第一の走査手段に対して相対的に被照射物を走査する第二の走査手段とを同期するように制御するとよい。

【0018】

また好ましくは、ビームのスポット形状を一定とするため、被照射物と走査手段との間にf θ レンズを配置するとよい。さらに入射角を一定とすることができるテレセントリックf θ レンズを用いると好ましい。このようなf θ レンズはサイズを大きくすることに限度があるが、被照射物を移動させジグザグ走査し、広範囲の領域に対して処理することができる。

【0019】

以上のような本発明の照射装置により、ビームの均一な領域、すなわち等速度に走査する領域のみを被照射物に照射することができ、均一な処理を行うことができる。

【0020】

さらに被照射物として半導体膜を用いる場合、結晶性や電気特性が揃った多結

晶 T F T を提供することができる。そのような多結晶 T F T を備えた液晶表示装置、自発光型素子を有する発光装置等の表示装置や C P U やメモリを有する集積回路回路は、表示の均一化、性能の向上等の効果が期待できる。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、実施の形態を説明するための全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。

【 0 0 2 2 】

（実施の形態 1）

本実施の形態では、具体的なビーム照射方法を、図 3 を用いて説明する。

【 0 0 2 3 】

まず図 3（A）に示すように、スポット 3 1 を走査手段により被照射物 3 2 上に走査させる。まずスポット 3 1 を第一の長軸方向（A 1）へ走査し、次いで短軸方向（B 1）に走査させ、さらに第 2 の長軸方向（A 2）へ走査し、再び短軸方向（B 1）に走査する。このような動作を繰り返すことで、被照射物の広範囲にスポット 3 1 を走査させることができる。このとき例えば、長軸方向の走査は第一の走査手段により行われ、短軸方向の走査は第 2 の走査手段による被照射物の移動により行われる。

【 0 0 2 4 】

また図 3（B）にはスポットの速度のグラフを例示する。図 3（A）とあわせてみると、スポットの速度が低減、増加する領域及び短軸方向領域、つまり（C 1）では、被照射物に光源との間に配置されるスリットやシャッター等により、C W ビームが照射されない遮断領域 3 3 となるようにする。そして順次走査（ジグザグ走査）を行い、被照射物全体にビームを照射する。

【 0 0 2 5 】

例えば、スポットサイズを $10 \times 500 \mu\text{m}$ とし、スポットの走査速度を 500 mm/s 、一筋で照射できる照射領域の長軸方向の長さを 100 mm とすると、スポットが 0.2 s 間で 100 mm 走査したのち、被照射物は走査で変質され

た被照射物の幅分だけ（本実施の形態では短軸方向に $200\ \mu\text{m}$ ）移動する。このとき遮光する領域（非照射領域）を両端 5mm とし、遮光板は 90mm 間隔で設けられている。そしてスポットが遮光されている間に、被照射物が短軸方向に $200\ \mu\text{m}$ 移動する。以上のような走査により、大面積を有する被照射物の全面を均一に処理することができる。

【0026】

遮光板は、ビームを反射する反射体や、ビームを吸収する吸収体等を有する構成であればよい。そして反射体から反射されるビームをダンパー等に吸収させてもよい。さらにダンパーには発熱を防ぐための冷却水を循環させると好ましい。また遮光板の材料としては、アルミニウムやステンレス等の金属材料、又はそれらの合金から形成することができ、例えばこれらに黒色を塗布して吸収体とすることができる。

【0027】

また遮光板は、被照射物と、第一の走査手段との間であって、被照射物上において、ビームの走査速度が変化するとき、ビームが被照射物に当たらないように配置する。この遮光板は、走査手段の付近に備えてもよい。また、被照射物の付近に固定してもよい。遮光板を走査手段付近に設ける場合、遮光板のサイズを小さくすることができ、結果として照射装置が小型化できる。また遮光板を被照射物付近設ける場合、正確に照射領域を制御できるので好ましい。

【0028】

また遮光板は、所定の照射領域が形成できればよく、遮光板の配置する間隔は、走査するビーム形状や照射領域を考慮して決定すればよい。第一の走査手段としてガルバノミラーを使用する場合、走査するビームの照射領域は $5\sim30\text{cm}$ 程度であり、遮光する領域を例えば両端 $0.5\sim2\text{cm}$ 程度とすると、遮光板の間隔は $1\sim29\text{cm}$ とする。

【0029】

なお本発明において、ビームと被照射物とは相対的に移動すればよく、ビームが移動しても、被照射物が移動しても、両方が移動しても構わない。被照射物の移動手段としては、 $X-Y$ 軸に移動するステージを用いればよい。例えば、 X 軸

方向に移動するレールと、Y軸方向に移動するレールとを交差して配置し、被照射物が吸着等により固定されたステージをXY方向に移動する。または被照射物を空気等により浮上させ、XY方向に移動させてもよい。また照射領域の短軸方向に移動させる場合、ビームの走査と同期するようにステージを制御する。

【0030】

特に、走査手段としてポリゴンミラーを用いる場合、ステージの移動距離は、ミラーごとに微調整すると好ましい。これは、ポリゴンミラーは複数のミラーを有するため、隣り合うミラーによるビームの反射方向が異なることが考えられるためである。例えば実施者は、複数のミラーに番号を付し、一度走査させる。このとき、各ミラーの移動の特性を把握し、これを踏まえてステージの移動を制御する制御装置を設置する。

【0031】

さらに光源を複数用いたり、複数の分光したりして、効率よく被照射物（特に大型面積のもの）にビームを照射するとよい。その結果、量産性が飛躍的に向上する。

【0032】

また特に大型基板から多面取りパネルを製造する場合、両端に配置される遮光板の間に必ず任意のパネルが入るようにビームの照射を行うとよい。そのように照射することで、一つのパネル全面に渡って均一に結晶化された半導体膜を形成することができる。そのため、薄膜トランジスタを設ける領域に制限がなく、設計の自由度を高めることができる。

【0033】

また被照射物がビームに対して透明な基板に成膜された半導体膜である場合、ビームを斜めに入射させてもよい。斜め入射により半導体膜表面からの反射光と基板の裏面からの反射光とが起こす干渉を防止することができる。

さらに該反射光を処理するためダンパー等を設けてもよい。ダンパーは、反射光を吸収する性質を有しており、さらにダンパー内に冷却水を循環させ、反射光の吸収により隔壁の温度が上昇するのを防ぐようにするとよい。

【0034】

このような本発明により、CWビームによる均一性の高い照射装置、及び処理方法を提供することができる。さらに本発明の照射装置及び処理方法を半導体膜の結晶化に用い、均一性の高い結晶性半導体膜、すなわち多結晶TFEを提供することができる。

【0035】

(実施の形態2)

本実施の形態では図1を用いて、CWレーザを用いたレーザ照射装置、及びレーザ照射方法を説明する。また被照射物として半導体膜を用い、第一の走査手段としてガルバノミラーを用いる一例を説明する。

【0036】

まず、レーザ発振器101から射出されるCWレーザビームが光学系102により長く引き伸ばされ、線状に加工される。具体的には、光学系102が有するシリンドリカルレンズや凸レンズを、レーザビームが通過すると線状に加工することができる。

【0037】

その後、線状に加工されたレーザビーム（以下、線状ビームと表記する）は、ガルバノミラー103と、 $f\theta$ レンズ104とを介して半導体膜106へ入射する。このとき線状レーザは、半導体膜上に所定の大きさのレーザスポット105を形成するように調整されている。また $f\theta$ レンズ104により、ガルバノミラーの角度によらず、被照射物表面において、レーザスポット105の形状が一定となる。

【0038】

なお図1においては、1500mm（図中Y方向の長さ）×1800mm（図中X方向の長さ）の大面积基板に成膜された半導体膜をレーザアニールする。 $f\theta$ レンズ104の直径は、100～300mm程度が現実的であり、すなわち幅100～300mmに渡って走査可能である。

【0039】

このときガルバノミラーの振動を制御する装置（制御装置）110によりガルバノミラーが振動、つまりミラーの角度が変化するようになっており、レーザス

ポット 105 は、一方向（例えば、図中の X 軸方向）に移動する。例えばガルバノミラーが半周期振動すると、レーザビームが半導体膜上の X 軸方向に一定幅移動するように調節されている（往路）。

【0040】

そして、半導体膜は XY ステージ 109 により Y 軸方向へ移動する。そして同様に、ガルバノミラーにより、レーザスポットが半導体膜上の X 軸方向に移動する（復路）。このようなレーザビームの往復運動を用いて 107 に示すような経路をレーザスポットが移動し、レーザアニールが行われる。

【0041】

なお往復運動の方向は、レーザスポットの長軸方向と垂直方向（図中、X 軸方向）にするとスループットが高いので好ましい。また、レーザスポットの長軸を往復方向とある角度を有するように、すなわち斜めになるように設定してもよい。

【0042】

往復運動の際、ガルバノミラー 103 の止まり際（Y 軸方向の移動領域を含む）で、レーザスポットの速度が一定でなく、増加、減少等してしまう。これによりレーザアニールの均一性が失われることが懸念されるが、本発明はレーザスポットの速度が一定でない領域に遮光板 108 を設け、当該領域へのレーザ照射を遮断する。遮光板の形状は実施者が適宜決定すればよい。

【0043】

遮光板の間隔は、スポットの形状や $f\theta$ レンズ 104 により決定されるレーザ照射領域に合わせて設定すればよく、例えば 3 ～ 30 cm の間隔となるように設定する。また遮光板の幅は、レーザ走査速度が一定になるまでの距離に合わせればよく、ガルバノミラーでは 1 ～ 10 mm 程度で十分である。また板状の遮光板に 3 ～ 30 cm の開口部を単数、又は複数設けてもよい。その結果、一回の振動で走査するスポット同士の重なりによる不均一なレーザ照射を防ぐことができる。

【0044】

ガルバノミラー 103 は一定の振動数で振り子運動を行い、その結果レーザス

ポット 105 は一定の往復運動を行う。そして XY ステージ 109 は、所定の長さずつ移動し、さらに、一列分のレーザ照射を終えると、次の列へ移るように矩形形状にも移動する。

【0045】

例えば、ガルバノミラー 103 を振動させながら、半導体膜において $100\text{ mm} \times 200\text{ }\mu\text{m}$ （一筋の X 軸方向へのレーザ照射領域の領域）の範囲を結晶化する。次いで、XY ステージ 109 により半導体膜 106 を $200\text{ }\mu\text{m}$ だけ Y 軸方向に移動させ、ガルバノミラー 103 の振動によりレーザビームを照射する。この繰り返し往復運動により、 $100\text{ mm} \times 1500\text{ mm}$ の一列の範囲を均一にレーザアニールを行うことができる。このとき遮光板の間隔は 100 mm とする。同様にその他の領域に対してレーザ照射を行って、半導体膜全体のレーザアニールを行う。本実施の形態の場合、上述した工程を 18 回繰り返すことで、 $1500 \times 1800\text{ mm}$ の半導体膜全体をレーザアニールすることができる。

【0046】

また一般に CW レーザは、干渉性が高い。そのためレーザの入射角を 0° 以上（斜め入射）とし、被照射物の裏面からのレーザの反射光が、被照射物の表面からのレーザの反射光と被照射面上で干渉しないようにするのが好ましい。

【0047】

このように本発明は、CW レーザと、ガルバノミラーやポリゴンミラー等の第一の走査手段と、XY ステージのような第二の走査手段と、 $f\theta$ レンズと、遮光板とを用いることにより、被照射物として大面積領域を照射する場合であっても、均一にむらなくレーザアニールすることができる。その結果、量産性が高まり、半導体装置の低コスト化につながる。

【0048】

以上、本実施の形態では第一の走査手段としてガルバノミラーを用いたが、ポリゴンミラーや回転機能をする単数鏡面を有するミラーを使用することができる。

【0049】

また本発明において、半導体膜を所望の形状、例えば島状、線状、パネル形状

にパターニングした後に、レーザ処理を行ってもよい。

【0050】

(実施の形態3)

本実施の形態では、基板上に形成される半導体膜に対して、複数のレーザ発振器を用いてレーザ処理を行い、薄膜トランジスタの量産性を高める場合を説明する。

【0051】

図2には、レーザ発振器201、テレセントリックfθレンズ204、ガルバノミラー203、一对のスリット207をそれぞれ3つ用い、1500mm×1800mmの大面积基板に成膜した半導体膜205に対してレーザアニールを行う場合の例を示す。なお図2(A)は上面図、(B)は側面図を示す。

【0052】

基板に下地膜として酸化膜(SiONやSiO₂などの酸化珪素膜)、半導体膜を順次成膜する。半導体膜はCVD法や、スパッタ法等を用い、珪素を主成分とする材料で形成すればよい。本実施の形態では、シランガスを用いたCVD法により非晶質珪素膜を成膜する。成膜方法によっては半導体膜中の水素濃度が高すぎて、レーザアニールに耐えられないものがある。そこで、レーザアニールに耐える確率を高くするため、半導体膜中の水素濃度が10²⁰/cm³オーダー以下とするとよい。そのため成膜が終了した時点で、水素濃度が上記の値以上である場合は、400～500℃程度の熱アニールにて、1時間程度の脱水素工程を行うとよい。このように形成された半導体膜に対してレーザアニールを行う。なおレーザアニール前に、半導体膜を所定の形状にパターニングしておいても構わない。

【0053】

レーザ発振器201は例えば、LD励起のCWのNd:YVO₄レーザの第2高調波(波長532nm)を用いる。出力は10Wとし、TEM₀₀モードのものを使用する。ビーム径はφ2.3mm、広がり角は0.35mradとする。

【0054】

なおこの波長は、非晶質珪素膜や基板に対して透光性を示すため、干渉によるレーザアニールの不均一を抑える工夫を施す必要が生じることがある。その場合

、例えば、レーザビームの半導体膜 205 に対する入射角を 0° 以外とするとよい。このとき適切な入射角は、レーザのスポット形状やサイズに依存する。レーザスポット 208 の引き伸ばす方向は、図 2 中の Y 軸方向である。目的によっては他の方向に引き伸ばすこともあるが、本実施例ではスループットを最大とするため Y 軸方向とする。例えば本実施の形態において、半導体膜 205 上のレーザスポットのサイズを長径 $400\ \mu\text{m}$ 、短径 $20\ \mu\text{m}$ の線状の楕円とし、入射面に長径が含まれるように設定すると、適正な入射角 θ は 20° 程度である。

【0055】

テレセントリック $f\theta$ レンズ 204 の焦点距離は 300mm 程度とし、 $\phi 120\text{mm}$ とする。光学系 202 はレーザビームのスポット形状を線状に加工するもので、例えば、焦点距離 50mm の平凹レンズと、焦点距離 200mm の平凸レンズを 145mm 離して配置し、さらに平凸レンズの後方 140mm に、焦点距離 250mm の平凸シリンドリカルレンズを配置し、さらに平凸シリンドリカルレンズの後方、 145mm に焦点距離 100mm の平凹シリンドリカルレンズを配置する。なお、平凸シリンドリカルレンズと平凹シリンドリカルレンズの曲率の方向は同じとする。さらに、平凹シリンドリカルレンズから 250mm 程度後方にガルバノミラー 203 を配置し、テレセントリック $f\theta$ レンズ 204 はそれらレンズの仕様に合わせて配置する。

【0056】

以上のような光学系を有するレーザ照射装置において、半導体膜 205 上で線状に伸ばされたレーザビームのスポット 208 は、ガルバノミラー 203 により、速度 500mm/s で半導体膜 205 上を走査する。レーザビームのスポット 208 が半導体膜 205 上で加減速する位置には遮光板 207 を設けて遮光領域とし、スポットの走査速度が一定の範囲のみ半導体膜に照射するようにする。このとき遮光板の間隔は 100mm とする。また、ガルバノミラーの加速は数 mm で十分であるため、遮光板の幅は 5mm とする。すなわち 110mm の範囲をガルバノミラー 203 で走査させ、その両端を 5mm ずつスリット 207 でカットとし、遮光領域とする。そしてレーザのスポットサイズにより決まる一度のガルバノミラーの動作でできる多結晶の領域の幅（Y 軸方向のスポット幅）を 200

μm とすると、ガルバノミラーによりレーザビームのスポット208をX軸方向に110mm走査させた後、XYステージ206をY方向に200 μm 移動させ、再びガルバノミラー203によりレーザビームのスポットを半導体膜205上で走査させる。

【0057】

以上を繰り返すことで、図中のA領域をレーザアニールする。A領域はレーザ発振器の数だけできるが、これらの間隔を100mmずつ開けておく。そして、A領域のアニールが終了後、XYステージ206により、B領域をレーザアニールできる位置まで半導体膜205を移動させる。そして、B領域をA領域と同様にレーザアニールする。これら一連の動作により、半導体膜205の全面をレーザアニールすることができる。もちろん、半導体膜205全面をレーザアニールする必要はなく、必要な位置のみレーザアニールするとより処理時間を短縮できるので好ましい。この場合、位置決め機構などを精密に作る必要があるが、その構成は実施者が必要な精度を算出し適宜決定するとよい。

【0058】

本実施の形態では、間隔を開けて複数のテレセントリックf θ レンズ204を配置している。そのため、隣り合うテレセントリックf θ レンズが干渉することなく、複数のレーザビームを半導体膜に同時に照射することが可能となる。これにより、レーザ発振器を1台のみ用いる場合と比較して高いスループットを得ることができ、特に大型基板に適す。本実施の形態では、レーザビームの半導体膜に入射する角度を一定とするためf θ テレセントリックレンズを用いる。これにより、レーザアニールの一様性が得られるが、要求されないときは代わりにf θ レンズを用いるとよい。

【0059】

以上のように半導体膜の結晶化が行われる。その後、半導体膜を必要に応じて所定の形状にパターニングし、ゲート絶縁膜、ゲート電極、不純物領域を形成し、活性化を行う。本発明のレーザ照射装置及び方法は、半導体膜の活性化にも使用することができる。そして、層間絶縁膜、ソース配線、ドレイン配線、画素電極等を形成し、複数の薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス基板が形

成される。またアクティブマトリクス基板を用いて、液晶表示装置、発光装置、その他の表示部を有する表示装置、又は半導体集積回路等を形成することができる。

【0060】

以上のように、複数のレーザ発振器を用いてレーザアニールを行うことによって、薄膜トランジスタの量産性を高めることができる。

【0061】

なお本実施の形態において、レーザ発振器を複数用いているが、一つのレーザ発振器からのレーザビームをミラー等により分割して、複数のスポットを形成しても構わない。

【0062】

以上、本実施の形態では第一の走査手段としてガルバノミラーを用いたが、ポリゴンミラーや回転機能をする単数鏡面を有するミラーを使用することができる。

【0063】

(実施の形態4)

本実施の形態では、アクティブマトリクス基板を用いて作製される発光装置について、図4を用いて説明する。

【0064】

図4(A)には、発光装置、具体的にはELモジュールの断面を示す。また図4(B)には、ELモジュールの発光素子(有機化合物層、第一の導電膜及び第二の導電膜を有する)の積層構造を拡大したものを示す。

【0065】

図4(A)において、第一の基板400、下地絶縁膜401、本発明のレーザ照射装置を用いてレーザアニールされて形成されるTF T 402、第一の導電膜(電極)403、絶縁物(隔壁、土手、バンクとも呼ばれる)404、有機化合物層405、第二の導電膜(電極)406、保護膜407、空隙408、第二の基板409である。

【0066】

第一の基板及び第2の基板としては、ガラス基板、石英基板やシリコン基板、プラスチック基板、金属基板、ステンレス基板、可撓性基板などを用いることができる。可撓性基板とは、PET、PES、PEN、アクリルなどからなるフィルム状の基板のことであり、可撓性基板を用いて半導体装置を作製すれば、軽量化が見込まれる。可撓性基板の表面、または表面および裏面にアルミ膜（AlO_N、AlN、AlOなど）、炭素膜（DLCなど）、SiNなどのバリア層を単層または多層にして形成すれば、耐久性やガスバリア性などが向上するので望ましい。

【0067】

なお有機化合物層からの発光が上方又は下方のいずれかに出射されるかにより、第一の導電膜及び第2の導電膜のいずれかを透光性とするITO等から形成する。また両方に出射する場合は、第一の導電膜及び第2の導電膜を、透光性を有する導電膜とすればよい。

【0068】

第一の基板400上に設けられたTFT402（pチャネル型TFT）は、有機化合物層405に流れる電流を制御する素子であり、ドレイン領域（またはソース領域）として機能する不純物領域411と、チャネル形成領域412と、チャネル形成領域上に設けられたゲート電極417を有する。また、第一の導電膜403に接続され、ドレイン領域（またはソース領域）に接続されるドレイン電極（またはソース電極）416を有する。また、ドレイン電極416と同じ工程で電源供給線やソース配線などの配線418が同時に形成される。

【0069】

第一の基材400上には下地絶縁膜（ここでは、下層を窒化絶縁膜、上層を酸化絶縁膜）となる下地絶縁401形成されており、ゲート電極417と半導体膜との間には、ゲート絶縁膜が設けられている。また、層間絶縁膜402は有機材料または無機材料を有するように形成される。ここでは図示しないが、一つの画素には、他にもTFT（nチャネル型TFTまたはpチャネル型TFT）を一つ、または複数設けている。また、一つのチャネル形成領域814を有するTFTを示したが、特に限定されず、複数のチャネルを有するTFTとしてもよい。

【0070】

加えて、ここではトップゲート型TFETを例として説明したが、TFET構造に関係なく本発明を適用することが可能であり、例えばボトムゲート型（逆スタガ型）TFETや順スタガ型TFETに適用することが可能である。

【0071】

また、第一の導電膜403は、発光素子の陽極（或いは陰極）となる。第一の導電膜において、透明導電膜を用いる場合、ITO（酸化インジウム酸化スズ合金）、酸化インジウム酸化亜鉛合金（ $\text{In}_2\text{O}_3\text{—ZnO}$ ）、酸化亜鉛（ ZnO ）等を用いることができる。

【0072】

また、第一の導電膜403の端部（および配線817）を覆う絶縁物404（バンク、隔壁、障壁、土手などと呼ばれる）を有している。絶縁物404としては、無機材料（酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコンなど）、感光性または非感光性の有機材料（ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジストまたはベンゾシクロブテン）、またはこれらの積層などを用いることができる。なお本実施の形態では、窒化シリコン膜で覆われた感光性の有機樹脂を用いる。例えば、有機樹脂の材料としてポジ型の感光性アクリルを用いた場合、絶縁物の上端部のみに曲率半径を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物として、感光性の光によってエッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光によってエッチャントに溶解性となるポジ型のいずれも使用することができる。

【0073】

また、有機化合物層405は、蒸着法または塗布法を用いて形成する。本実施の形態では、有機化合物層を蒸着装置で成膜を行い、均一な膜厚を得る。なお、信頼性を向上させるため、有機化合物層405の形成直前に真空加熱（ 100°C ～ 250°C ）を行って脱気を行うことが好ましい。例えば、蒸着法を用いる場合、真空度が $5 \times 10^{-3} \text{ Torr}$ （ 0.665 Pa ）以下、好ましくは 10^{-4} ～ 10^{-6} Pa まで真空排気された成膜室で蒸着を行う。蒸着の際、予め、加熱により有機化合物は気化されており、蒸着時にシャッターが開くことにより基板の方向

へ飛散する。気化された有機化合物は、上方に飛散し、メタルマスクに設けられた開口部を通して蒸着される。

【0074】

なお図4 (B) に示すように、有機化合物層 (EL層) 405は、陽極側から順に、HIL (ホール注入層)、HTL (ホール輸送層)、EML (発光層)、ETL (電子輸送層)、EIL (電子注入層) の順に積層されている。代表的には、HILとしてCuPc、HTLとして α -NPD、ETLとしてBCP、EILとしてBCP:Liをそれぞれ用いる。

【0075】

また、有機化合物層 (EL層) 405として、フルカラー表示とする場合、赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の発光を示す材料を、それぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法などによって適宜、選択的に形成すればよい。具体的には、HILとしてCuPcやPEDOT、HTLとして α -NPD、ETLとしてBCPやAlq₃、EILとしてBCP:LiやCaF₂をそれぞれ用いる。また例えばEMLは、R、G、Bのそれぞれの発光色に対応したドーパント (Rの場合DCM等、Gの場合DMQD等) をドーピングしたAlq₃を用いればよい。なお、上記有機化合物層の積層構造に限定されない。

【0076】

より具体的な有機化合物層の積層構造は、赤色の発光を示す有機化合物層807を形成する場合、例えば、CuPcを30nm形成し、 α -NPDを60nm形成した後、同一のマスクを用いて、赤色の発光層としてDCM₂及びルブレンが添加されたAlq₃を40nm形成し、電子輸送層としてBCPを40nm形成し、電子注入層としてLiが添加されたBCPを1nm形成する。また、緑色の発光を示す有機化合物層を形成する場合、例えば、CuPcを30nm形成し、 α -NPDを60nm成膜した後、同一の蒸着マスクを用いて、緑色の発光層としてクマリン545Tが添加されたAlq₃を40nm形成し、電子輸送層としてBCPを40nm形成し、電子注入層としてLiが添加されたBCPを1nm形成する。また、青色の発光を示す有機化合物を含む層を形成する場合、例えば、CuPcを30nm形成し、 α -NPDを60nm形成した後、同一のマ

クを用いて発光層としてビス〔2-（2-ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサゾラト〕亜鉛： $Zn(PBO)_2$ を10nm形成し、電子輸送層としてBCPを40nm成膜し、電子注入層としてLiが添加されたBCPを1nm形成する。

【0077】

以上、各色の有機化合物層のうち、共通しているCuPcや α -NPDは、画素部全面に形成することができる。またマスクは、各色で共有することもでき、例えば、赤色の有機化合物層を形成後、マスクをずらして、緑色の有機化合物層、再度マスクをずらして青色の有機化合物層を形成することができる。なお、形成する各色の有機化合物層の順序は適宜設定すればよい。

【0078】

また白色発光の場合、カラーフィルターや色変換層などを別途設けることによってフルカラー表示を行ってもよい。上方に発光する白色光に対するカラーフィルターや色変換層は、第2の基板に設けた後、張り合わせればよい。また、下方に発光する白色光に対するカラーフィルターや色変換層は、ドレイン電極（またはソース電極）416を形成後、絶縁膜を介して形成することができる。その後、カラーフィルターや色変換層上に絶縁膜、第2の導電膜の順に形成し、ドレイン電極（またはソース電極）416と第2の導電膜とは、絶縁膜に形成されるコンタクトを介して接続すればよい。

【0079】

CWレーザによる均一性の高い本発明のレーザ照射装置、及びレーザ照射方法により、均一性の高い結晶性半導体膜を有する発光装置を提供することができる。その結果、表示部において、レーザムラ（表示ムラとなる）の低減された発光装置を提供することができる。

【0080】

なお、本発明のアクティブマトリクス基板は液晶表示装置やその他の表示装置、更には半導体集積回路やCPUにも採用することができる。

【0081】

（実施の形態5）

本発明により作製されたアクティブマトリクス基板は、様々な電子機器に適用

することができる。電子機器としては、携帯情報端末（携帯電話機、モバイルコンピュータ、携帯型ゲーム機又は電子書籍等）、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、表示ディスプレイ、ナビゲーションシステム等が挙げられる。これら電子機器の具体例を図5に示す。

【0082】

図5（A）はディスプレイであり、筐体4001、音声出力部4002、表示部4003等を含む。本発明により形成されたアクティブマトリクス基板により発光素子又は液晶材料を有する表示部4003を完成することができる。表示装置は、パソコン用、TV放送受信用、広告表示用など全ての情報表示装置が含まれる。

【0083】

図5（B）はモバイルコンピュータであり、本体4101、スタイラス4102、表示部4103、操作ボタン4104、外部インターフェイス4105等を含む。本発明により形成されたアクティブマトリクス基板により発光素子や液晶材料を有する表示部4103を完成することができる。

【0084】

図5（C）はゲーム機であり、本体4201、表示部4202、操作ボタン4203等を含む。本発明により形成されたアクティブマトリクス基板により発光素子や液晶材料を有する表示部4202を完成することができる。図5（D）は携帯電話機であり、本体4301、音声出力部4302、音声入力部4303、表示部4304、操作スイッチ4305、アンテナ4306等を含む。本発明により形成されたアクティブマトリクス基板により発光素子や液晶材料を有する表示部4304を完成することができる。

【0085】

図5（E）は電子ブックリーダーであり、表示部4401等を含む。本発明により形成されたアクティブマトリクス基板により発光素子や液晶材料を有する表示部4202を完成することができる。

【0086】

以上のように、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用

いることが可能である。特に、アクティブマトリクス基板の絶縁基板をフレキシブル基板とすることで薄型や軽量が実現することができる。

【 0 0 8 7 】

【発明の効果】

本発明の走査手段を用いることで、被照射物上を走査する CW ビームにおいて、ビームの走査方向が変わる領域、又は等速度運動が行われない領域に遮光板を配置することにより、均一な処理が行われる。その結果、半導体膜の均一なアニールを提供することができる。以上のようにして、被照射物、特に半導体膜の膜剥がれを防止することができる。また、大型基板に形成された半導体膜から多面取りを行う場合、当該半導体膜のレーザアニールに適する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明のレーザ照射装置を示す図。

【図 2】 本発明のレーザ照射装置を示す図。

【図 3】 本発明のレーザ照射方法を示す図。

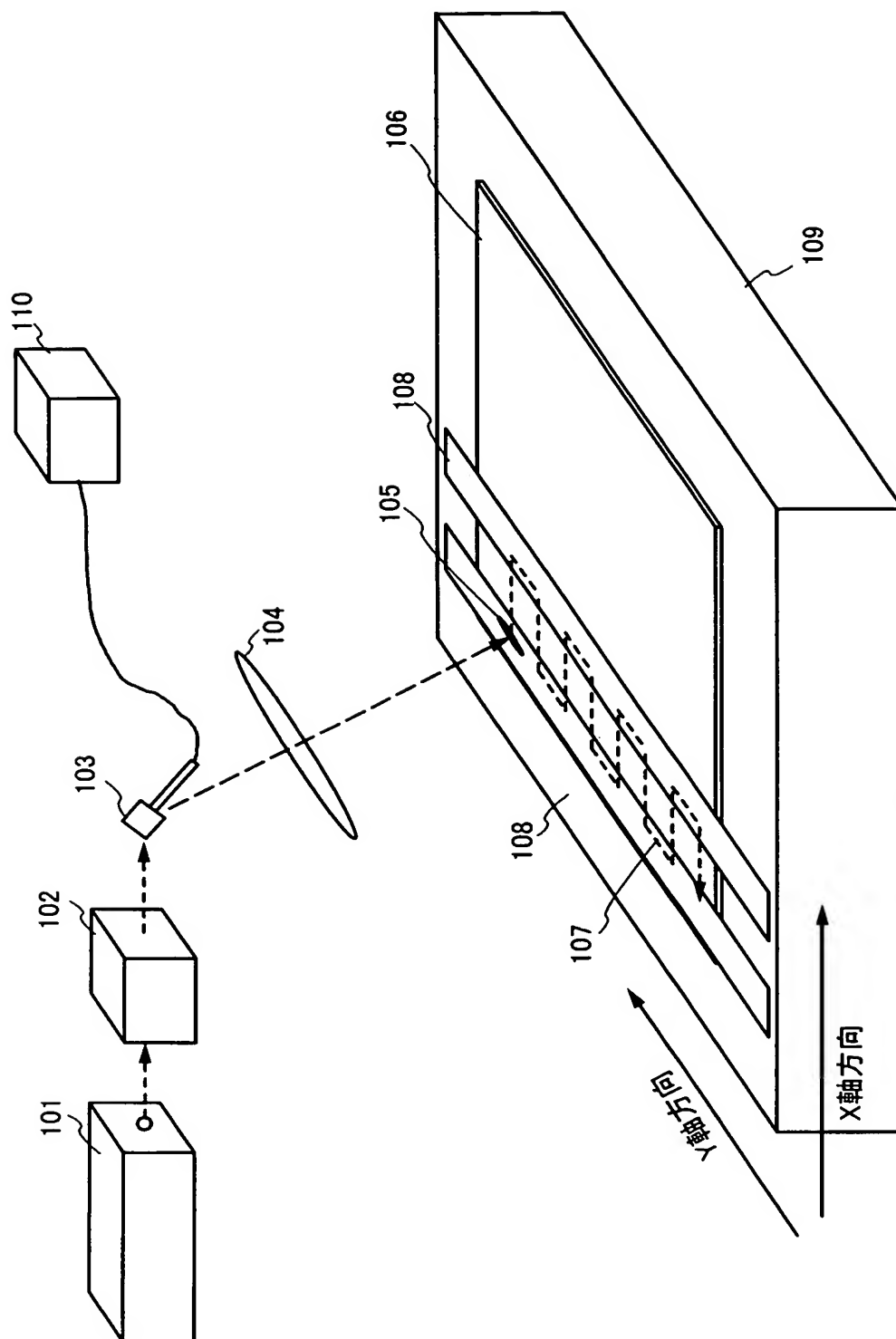
【図 4】 本発明のレーザ照射方法を用いて形成される発光装置を示す図。

【図 5】 本発明のレーザ照射方法を用いて形成される電子機器を示す図。

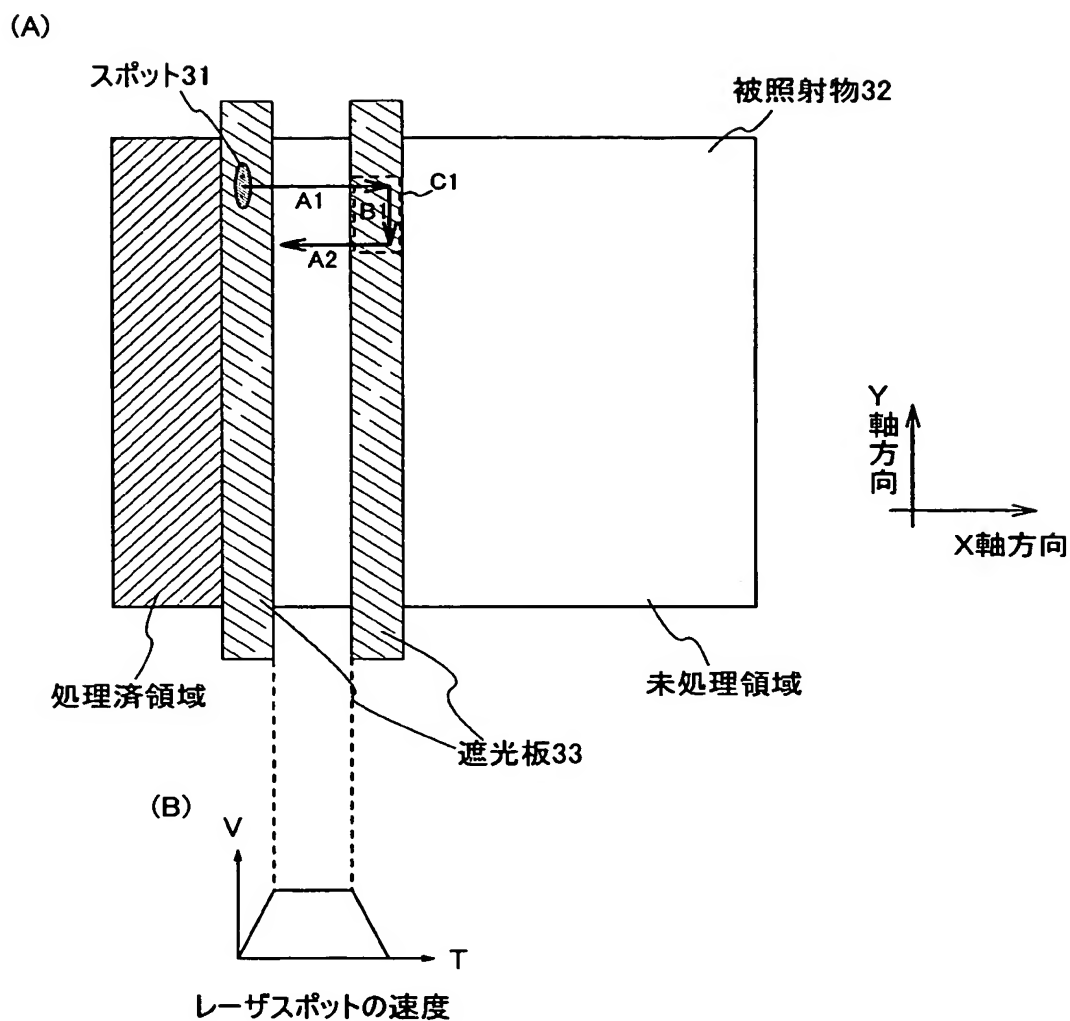
【書類名】

図面

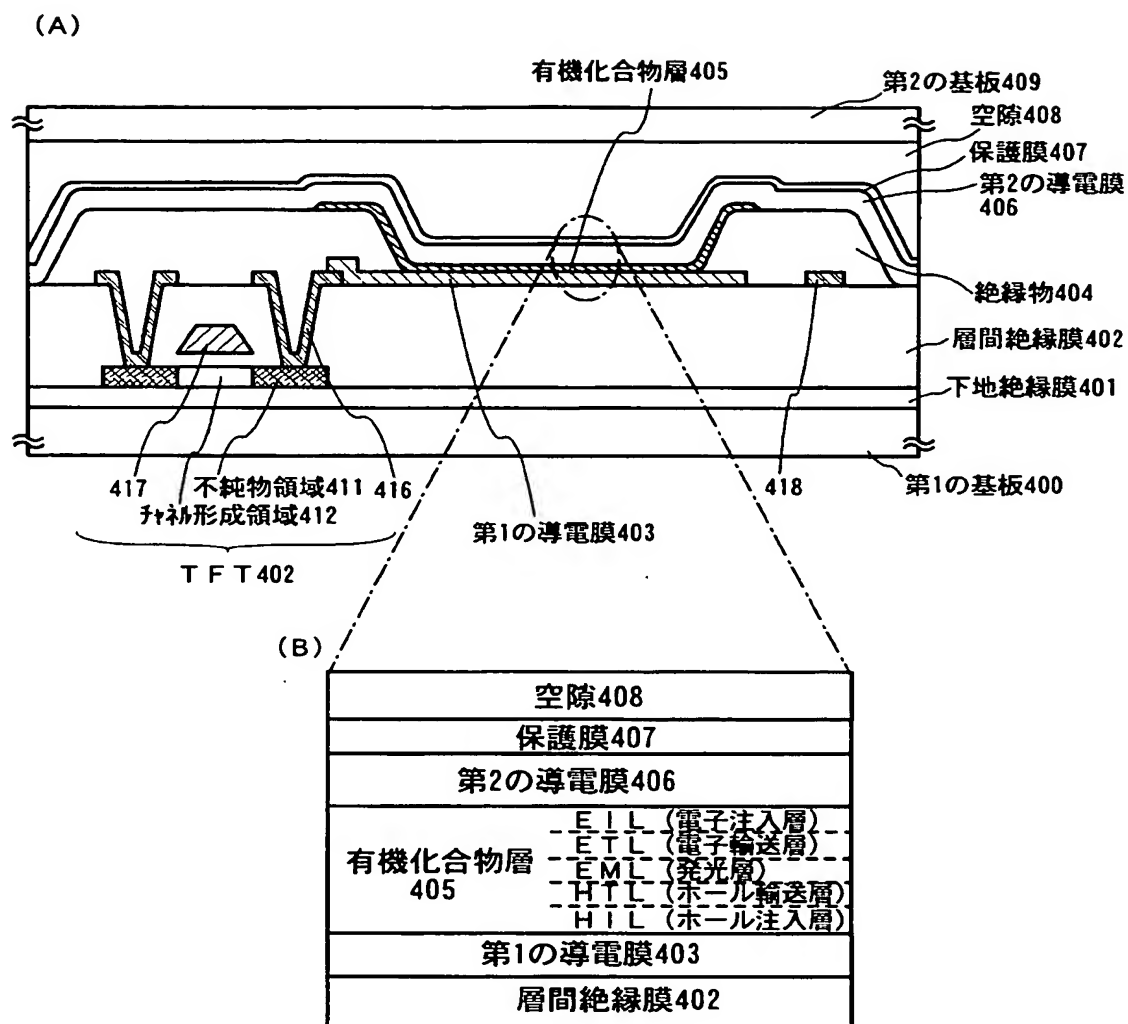
【図 1】



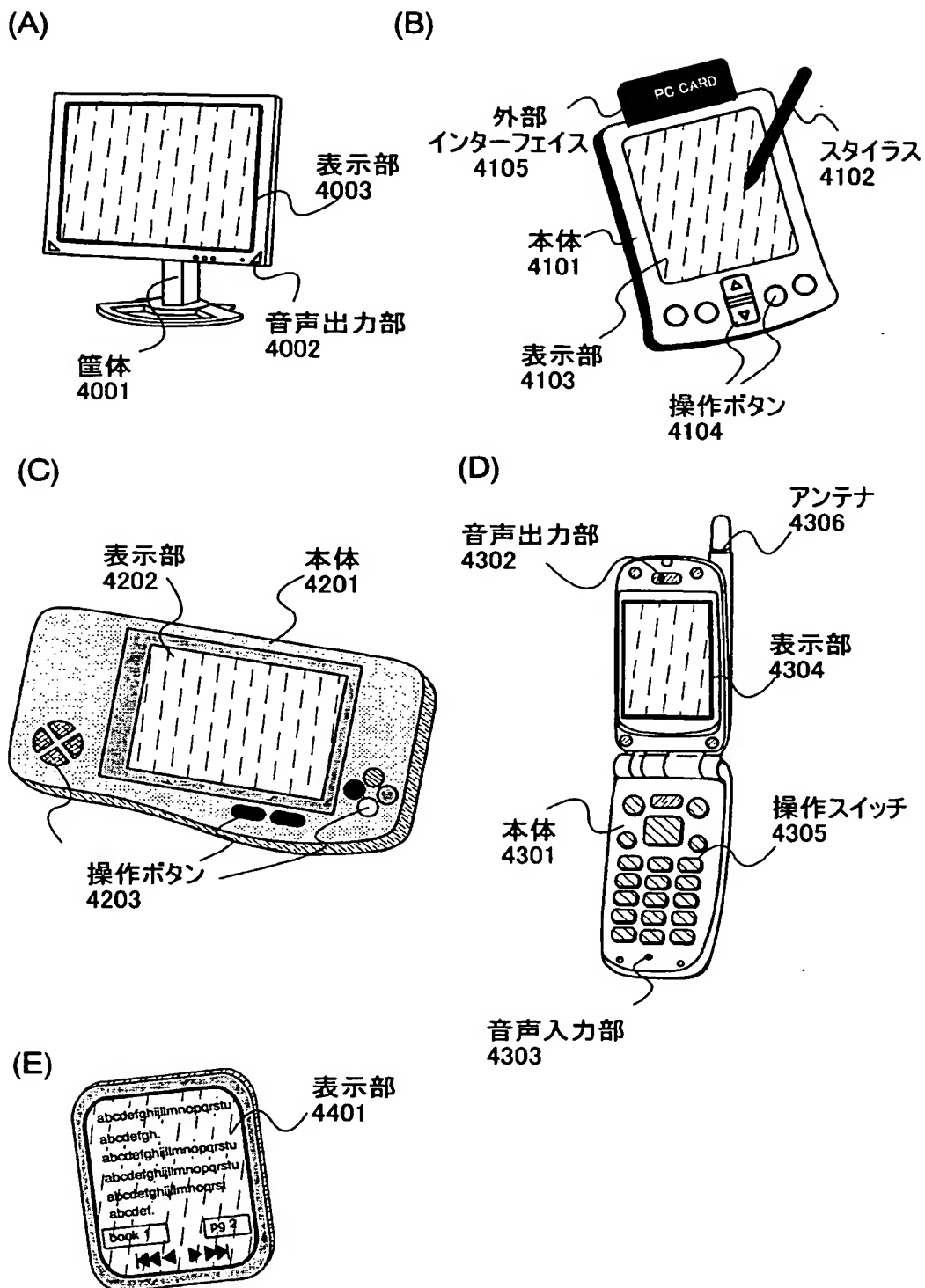
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ガルバノミラーやポリゴンミラー等の走査手段により走査されるレーザの速度は、走査幅の中心部と端部とで速度が一樣とならなかった。その結果、被照射物に必要以上のエネルギーが照射され、非晶質半導体膜に膜剥がれ等が生じる恐れがあった。

【解決手段】 本発明は、連続的に出力されるエネルギービームの被照射物上でスポットを、走査手段により走査する場合、スポットの走査速度が例えば速度が一定でなく、増加、減少及びゼロの領域、つまり走査開始位置及び走査終了位置となるときの、被照射物に照射されるCWビームを遮断することを特徴とする。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 1 6 3 9 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 1 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
氏 名	株式会社半導体エネルギー研究所